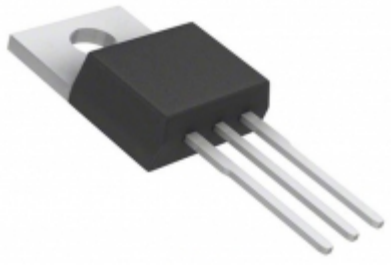
	<h2 style="color: #E67E22;">FDP060AN08A0</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP060AN08A0</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP060AN08A0.pdf 2.FDP060AN08A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24836 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>YIC International Co., Limited.</small></p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP060AN08A0
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24836 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP060AN08A0 ist neu im Original, Suche FDP060AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP060AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP060AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP060AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP060N08A0 VB FDP060N08A0 VB</p>	 <p>FDP060AN80A0 FSC FSC TO-220F</p>	 <p>FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDP068AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor FDP068AN08A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP060N08A0 VB FDP060N08A0 VB</p>	 <p>FDP054N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP054N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP038AN06A0	↔ FDP038AN06A0	⇒ FDP038AN06A0	D FDP039N08B	⇒ FDP040N06
⊣ FDP040N06	⊗ FDP045N10A	D FDP045N10A	⇒ FDP047AN08	⇒ FDP047AN08A0
⊗ FDP047AN08A0	⊣ FDP047AN08A0	⊗ FDP047N08	↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08A0
D FDP047N10	⊗ FDP047N10	⊣ FDP050AN06A0	⊗ FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06A0
⇒ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102	⊗ FDP054N10	⊣ FDP054N10	⇒ FDP060AN08A0
↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060N08A0	D FDP060N08A0	⊗ FDP068AN08A0	⊣ FDP070AN06A0
⊗ FDP070AN06A0	D FDP070AN06A0	⇒ FDP075N15A	↔ FDP075N15A	⇒ FDP083N15A
⊣ FDP083N15A	⊗ FDP083N15A_F102	↔ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A_F102
⊗ FDP090N10	⊣ FDP090N10	⊗ FDP100N10	D FDP100N10	⇒ FDP10AN06A0
↔ FDP10AN06A0	⊗ FDP10AN06A0	⊣ FDP10N60NZ	⊗ FDP10N60NZ	⇒ FDP120AN15A0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited